

Support De Nettoyage De Wafers En Ptfé De 6 Pouces - Porte-Wafers En Fluoropolymère Résistant Aux Acides Et Aux Alcalis Pour Gravure Humide

Numéro d'article: PL-CP421



Introduction

Supports de nettoyage de wafers en PTFE de 6 pouces haute pureté, conçus pour les processus de gravure humide agressifs. Ces porte-wafers en fluoropolymère résistant aux acides offrent une stabilité chimique exceptionnelle et une contamination ultra-faible pour la fabrication de semi-conducteurs, les analyses de trace exigeantes en laboratoire et le traitement chimique.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Gravure humide pour semi-conducteurs	Traitement de wafers de silicium dans des bains de HF, BOE ou d'acide phosphorique chaud.	Empêche la contamination métallique et résiste aux produits chimiques agressifs.
Fabrication de cellules solaires	Nettoyage et texturation de substrats de silicium pour la production de cellules photovoltaïques.	Durabilité pour le haut volume et résistance aux solutions de texturation caustiques.
Analyse des métaux traces	Nettoyage de la verrerie de laboratoire et des substrats avant analyse par ICP-MS.	Niveaux de fond ultra-bas et absence de lessivage d'ions pour des données précises.
Fabrication de MEMS	Manipulation de systèmes micro-électromécaniques pendant la gravure ionique réactive profonde ou la libération humide.	Manipulation délicate avec une haute précision dimensionnelle pour les structures fragiles.
Dépôt chimique en phase vapeur	Pré-nettoyage des substrats pour assurer une croissance de couche mince de haute qualité.	Garantit une surface atomiquement propre en résistant aux acides de prétraitement.
Nettoyage pharmaceutique	Stérilisation et nettoyage de composants haute pureté dans la R&D pharmaceutique.	Matériau conforme à la FDA avec une excellente résistance aux agents de stérilisation.
Procédés de galvanoplastie	Maintien des substrats pendant le dépôt métallique précis dans des bains acides ou alcalins.	Isolation électrique et résistance complète aux électrolytes de plaqage.

Catégorie de spécification	Détails pour le PL-CP421
Référence du modèle	PL-CP421
Matériau de base	PTFE vierge haute pureté (PFA/TFM disponible sur demande)
Diamètre de wafer principal	Standard 6 pouces (150 mm)
Capacité en wafers	Entièrement personnalisable (ex : 25 fentes, 50 fentes ou nombre sur mesure)
Largeur/Pas des fentes	Personnalisable selon l'épaisseur du substrat et les exigences d'espacement
Conception de la poignée	Fixe, amovible ou étendue (personnalisée selon la profondeur du bain)
Résistance à la température	-200°C à +260°C (-328°F à +500°F)

Application	Description	Avantage clé
Catégorie de spécification	Détails pour le PL-CP421	
Méthode de fabrication	Usinage CNC de précision 5 axes	
Finition de surface	Ra < 0,8µm (typique) ou polissage personnalisé	
Compatibilité chimique	Universelle (sauf pour les métaux alcalins fondus et le fluor élémentaire)	
Conformité	Qualité semi-conducteur / Qualité analyse de trace	